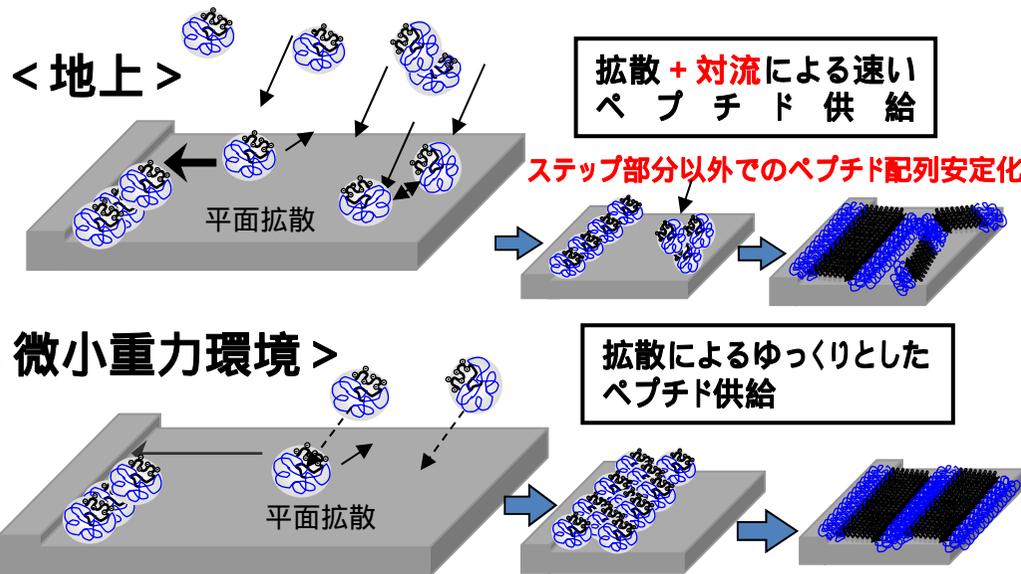
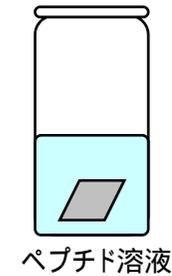
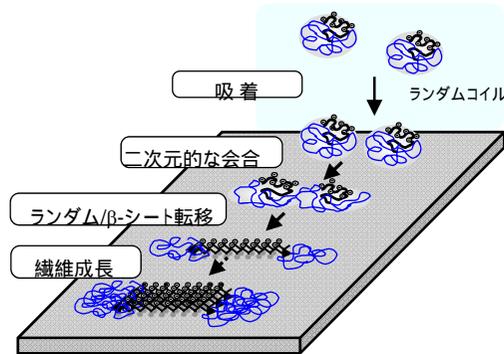
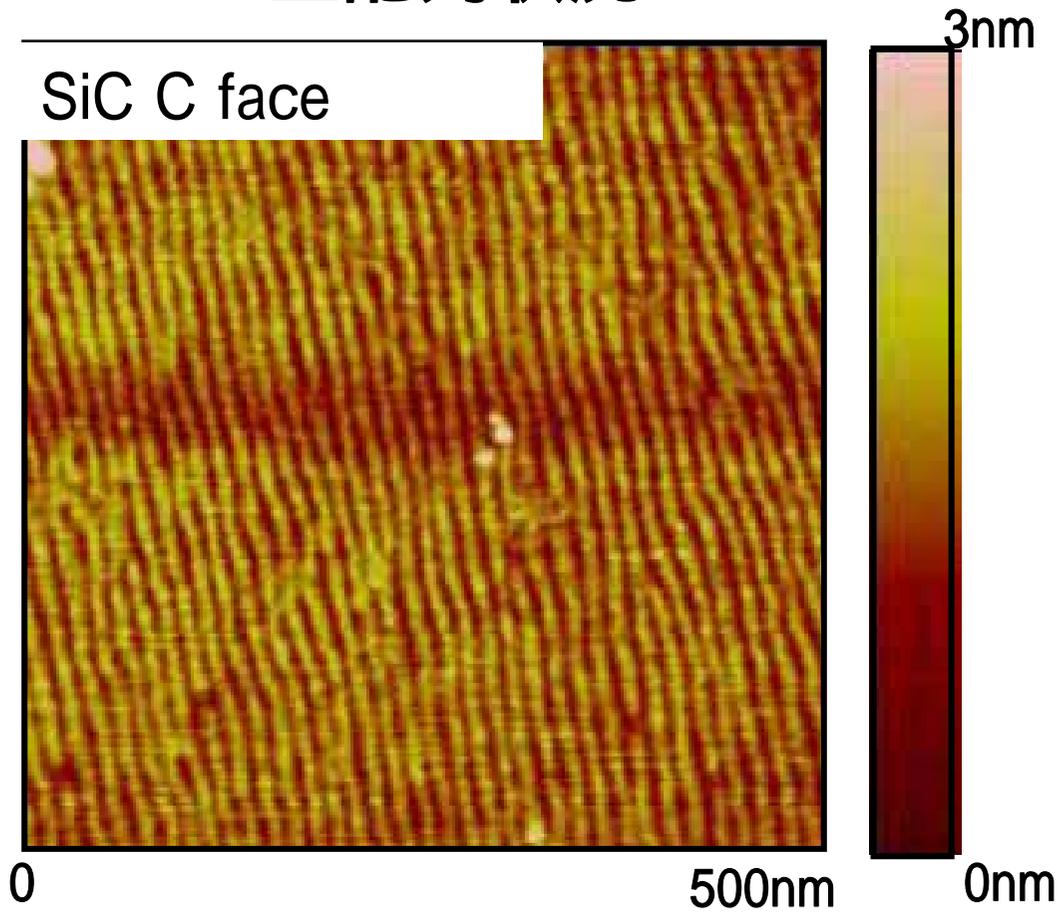


μG環境はペプチドを擾乱から解放する

平成26年2月13日@名古屋工業大学



SiC上配列状況



平成26年2月13日@名古屋工業大学

ナノ構造上にGaNを成長させました

G3639: 直接成長

i-GaN 2.3 μ m 760Torr 1130
ペプチド及びCMP加工 SiC 基板

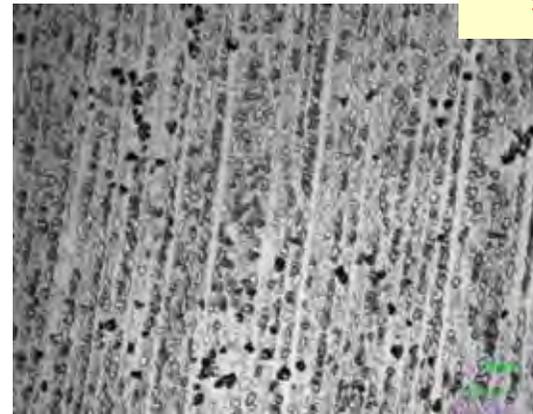
成長前基板洗浄

1. 超音波有機洗浄(アセトン, IPA)
2. HF (2.5%水溶液 1分間)
3. 硫酸過水溶液
(硫酸:過水=4:1 5分間)
4. HF (2.5%水溶液1分間)

ナノ構造に沿った
特異な成長



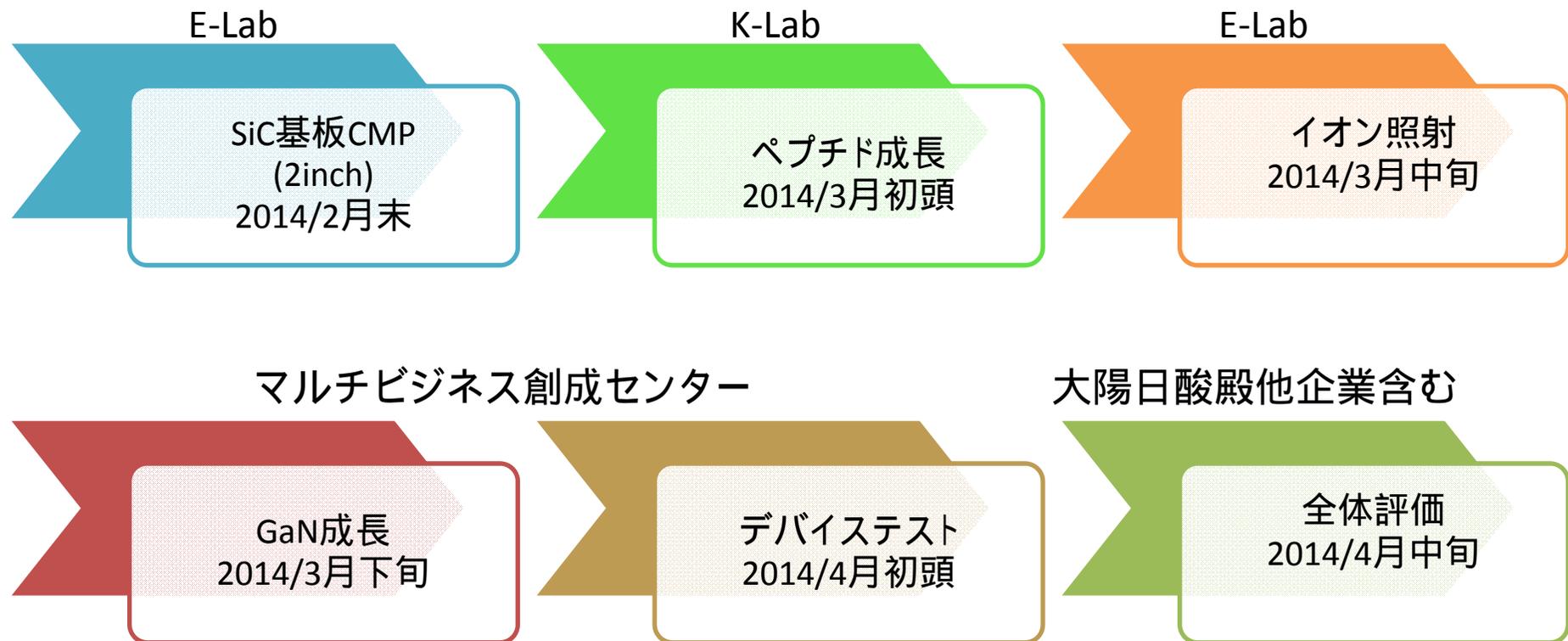
CMP



ナノ構造上

平成26年2月13日@名古屋工業大学

GaN種結晶基板成長計画(最速)



結言

- 素材電荷配列を活かしたものづくりに成功

今後

GaN成長によって省エネ社会を実現する企業との共創によって、ISS発ものづくりを価値化する